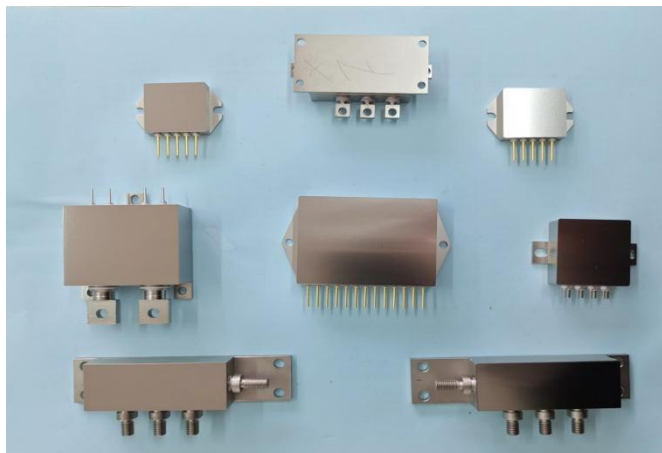




金属全密封晶闸管模块说明书

一、特性

- 1、芯片采用沟槽氮化硅玻璃烧结工艺。
- 2、通态压降低，功耗小。
- 3、高温 125℃ 下反向漏电流小。
- 4、浪涌电流能力强。
- 5、金属全密封结构，安装方便，可靠性高。
- 6、热性能好。



二、质量等级

- 1、企军标 JP、JT: GJB33A-97
- 2、七专 G: QZJ840611A
- 3、普军 J: 参考 QZJ840611A 执行。

三、金属全密封晶闸管模块额定值和特性参数

表 1: 金属全密封晶闸管模块额定值和特性参数表

电参数 产品型号	$I_{T(AV)}$	V_{DRM}/V_{RRM}	I_{DRM} 、 I_{RRM}	V_{TM}	T_{JM}	I_{GT}	V_{GT}	R_{jc}	产品外形 图	备注
	A	V	mA	V	°C	mA	V	°C/W		
MTC MTA MTK MTX MFC	25	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.78	图 10-1	产品详细电特性、外形图以各产品的技术规格书为准。
	40	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.55	图 10-2	
	55	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.5	图 10-3	
	70	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.33	图 10-4	
	80	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.29	图 10-5	
	90	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.27	图 10-5	
	110	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.25	图 10-5	
	130	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.25	图 10-6	
160	200~1800	≤3	≤1.4	125	10~100	≤2	0.25	图 10-6		

四、此类模块电极与壳体间绝缘电压均大于 2500V。

五、电连接方式见 99 页

六、产品安装注意事项，详见本手册第 116 页。



附图 10: 金属全密封晶闸管模块外形图

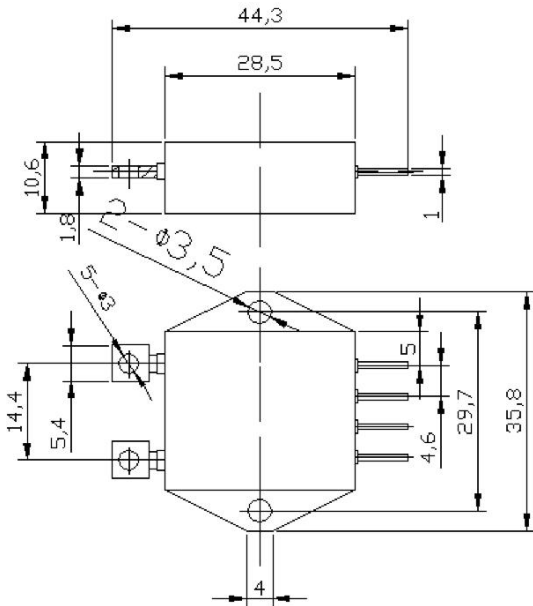


图 10-1: 全密封晶闸管外形图 1

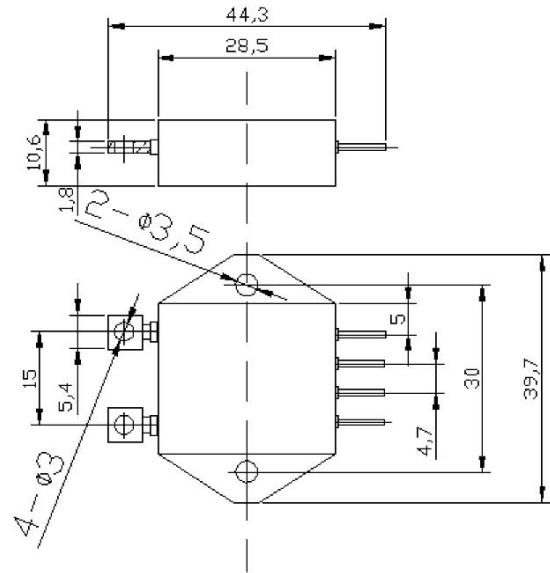


图 10-2: 全密封晶闸管外形图 2

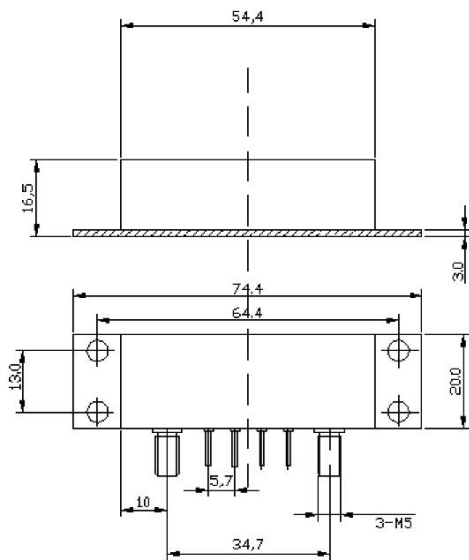


图 10-3: 全密封晶闸管外形图 3

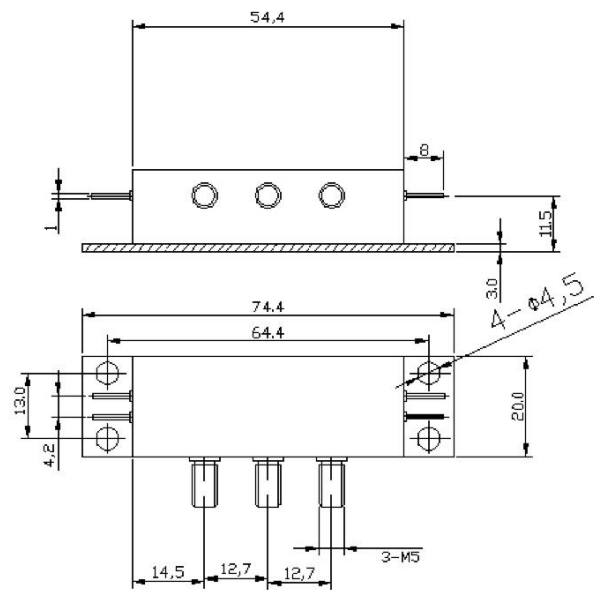


图 10-4: 全密封晶闸管外形图 4

